# ナノインデンテーション中のマグネシウムの

# 局所塑性変形挙動の原子論的解析

東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 助教 佐藤 悠治 (2021 年度 奨励研究助成(若手研究者枠) AF-2021038-C2)

キーワード:ナノインデンテーション、マグネシウム、分子動力学シミュレーション

#### 1. 研究の背景と目的

マグネシウム(Mg)は実用金属材料の中でも軽量であり, 高い比強度や比剛性,振動吸収性を有することが知られて いる1).現在主要な構造材料として使用されている鉄鋼材 料と比較して資源も豊富であるため、省エネルギー社会を 実現するための軽量構造材料としての利用が期待されて いる.しかしながらマグネシウムの結晶構造は対称性の低 い六方稠密(HCP)構造であるため、等価なすべり系の数 が少なく,主すべり系である底面すべりの室温での臨界分 解せん断応力 (CRSS) は他の柱面すべり, 錘面すべりとい ったすべり系と比べてきわめて低い2). ゆえに底面に関し ては容易にすべり変形が生じるが,非底面のすべりは生じ にくいという顕著な変形異方性を有し、それに起因する塑 性加工性の悪さが所望の形状に Mg を加工する上での課題 となっている. Mg の塑性加工性向上のための指針を得る に当たっては,塑性変形機構を根源的に理解することが必 要であると考える.

巨視的に見られる材料の塑性変形は材料中に存在して いる欠陥の挙動が平均化されたものであり、その構成要素 は微視的スケールにおいて生じる一つ一つのイベントで ある. Mg の塑性変形機構の理解に当たっては、材料の局 所的な力学応答を獲得することが可能な材料試験法であ るナノインデンテーションを用い、微小領域での塑性変形 挙動を解析することが有効であると期待される.ナノイン デンテーションにおいて観測される塑性変形に関するイ ベントとして、圧子の変位バースト現象である pop-in 現 象がある. この pop-in 現象は転位核生成やその後の転位 の集団運動に起因するイベントとして知られている<sup>3)</sup>.ナ ノインデンテーション中の pop-in 現象の挙動を解析する ことで、Mg の塑性変形機構の解明に資する有益な知見を 得ることが可能であると考える.

本研究では Mg の底面および柱面に対するナノインデン テーションの分子動力学(MD)シミュレーションによって, 転位核生成に起因する最初の pop-in 現象(第一 pop-in) が発生する荷重の温度・押し込み速度依存性の予測を実施 したので報告する.

#### 2. 解析方法

第一 pop-in 発生荷重の予測は以下の 3 段階にて実施する.まずナノインデンテーション MD 解析を実施し, pop-

in に起因する転位核生成が生じるまでの数段階における 圧子直下の各原子に生じる応力状態を取得する (Step 1). 次にこの原子応力状態を基に, NEB 解析によってナノイン デンテーション中における転位核生成過程の最小エネル ギー経路を求め,転位核生成発生のための活性化エネルギ ーを算出する (Step 2).そして得られた活性化エネルギ ーと,温度および押し込み速度を遷移状態理論に基づく確 率数理モデルに代入することで第一 pop-in 発生の確率分 布を計算し,発生荷重の温度・押し込み速度依存性を予測 する (Step 3).各解析項目の詳細を以下に示す.

# 2.1 ナノインデンテーション MD 解析による応力状態の 取得(Step 1)

ナノインデンテーションにおける材料中の応力状態を 取得するため,汎用 MD 解析コード LAMMPS<sup>4)</sup>を用い,直方 体状の Mg 単結晶のモデルの底面および柱面に対し,球状 圧子によるナノインデンテーションの MD 解析を実施した. 底面押し込みの条件での解析モデルを図1に示す.モデル は原子数1,440,000,サイズ 32.1 nm×33.4 nm×31.3 nm, 結晶方位は底面[0001],柱面[1100],錐面[1120]とした. 押し込みを行う面以外には周期境界条件を課した.原子間 相互作用を表現するためのポテンシャルは Wu らによる MEAM ポテンシャルを用いた<sup>5)</sup>.このモデルに対して,半径 10 nm の球状圧子を速度 4 m/s で押し込みを行った.



図1 ナノインデンテーション MD 解析のモデル (底面押し込み)

この圧子には、半径R内において次式で表される大きさFの斥力が生じる.

$$F(r) = \begin{cases} -K(r-R)^2 & (r < R) \\ 0 & (r \ge R) \end{cases}$$
(1)

ここでrは原子と圧子中心との距離である.またKは定数 であり、本解析では 10  $eV/Å^3$ とした.

本研究ではすべり方向に対して最大の分解せん断応力 が生じた箇所から転位核生成が発生すると仮定し,MD 解 析中にて転位核生成が発生するまでの数段階において 各々の原子に対して発生する応力状態を原子応力テンソ ルとして記録する.それらの原子応力テンソルに対して, HCP 構造の3つの底面すべり系へ座標変換し,すべり方向 への分解せん断応力成分が最大であるものを特定した.

## 2.2 ナノインデンテーション中の転位核生成過程の最 小エネルギー経路解析 (Step 2)

ナノインデンテーション中に生じる原子応力状態を考 慮した転位核生成の活性化エネルギーを計算するため,最 小エネルギー経路解析手法である Nudged Elastic Band (NEB) 法<sup>6)</sup> に基づく解析を実施した. Step 1 のナノイン デンテーション MD 解析での底面押し込み,柱面押し込み の各条件において,得られた圧子直下の応力状態(原子応 カテンソル)を均一に作用させた直方体状の完全結晶のモ デルを作成し、このモデルを NEB 解析の初期状態とした. また、この初期状態に等しいサイズのモデルに転位ループ を導入したモデルを作成し、これを最終状態とした. 直方 体状のモデルについて, x軸をすべり面となる底面に垂直 に、y軸をすべり方向に平行にとり、xy平面に直交するよ うにz軸をとった.モデルの原子数は 432,000, サイズは 10.4 nm×28.9 nm×33.4 nm である. 初期状態, 最終状態 のモデルともに、Step 1のナノインデンテーション MD 解 析において記録した数段階の押し込み変位での原子応力 テンソルに応じてそれぞれ変形させた.



(a) 初期状態 (b) 最終状態 (転位ループのみ表示)

NEB 解析に用いた初期状態と最終状態のシミュレーションモデルを図2に示す.なお最終状態のモデル(図2(b)) については配位数で色分けをし,転位ループの部分のみを 表示した形で示している.転位ループはx軸の中心に最も 近い,隣接する2つの原子層(すべり面)を半径r<sub>d</sub>の円盤 状に指定し,これらの層を互いに逆向きに,バーガースベ クトルbの1/2だけ移動させることで導入した.NEB 解析 によって得られた最小エネルギー経路において,初期状態 でのポテンシャルエネルギーと最もエネルギーの高い位 相点(鞍点)でのポテンシャルエネルギーとの差をとるこ とにより,活性化エネルギーEを計算した.次のStep3に て実施する pop-in 荷重の予測に用いるため,押し込み荷 重ごとに求めた活性化エネルギーEに対し,次式を用いて フィッティングを行った.

$$E(P) = E_0 \left\{ 1 - \left(\frac{P}{P_c}\right)^{\alpha} \right\}^{\beta}$$
(2)

ここで $P_{c}$ は活性化エネルギーがゼロとなる臨界荷重,  $E_0$ はP = 0 N の無負荷状態での活性化エネルギー,  $\alpha, \beta$ は関 数の形を決定するためのパラメータである.本研究では $P_{c}$ は Step 1 のナノインデンテーション MD 解析にて転位核 生成が生じた際の荷重とし,残る $E_{0}, \alpha, \beta$ をフィッティング によって求めた.

# 2.3 ナノインデンテーション中の pop-in 発生荷重の確 率分布の計算(Step 3)

Step 2にて得られた活性化エネルギーE(P)を基に、反応速度に関するアレニウスの式とそれにより導かれる確率密度関数から pop-in 発生荷重の温度・押し込み速度依存性を予測する. 遷移状態理論よりP = 0 N の無負荷状態を初期状態とし、一定温度T、一定押し込み速度Pのもとで荷重がPとなったときに pop-in が生じる確率密度p(P)と、累積確率Q(P)は次式で表される.

$$p(P) = \frac{k(P) \exp\left\{-\dot{P}^{-1} \int_{0}^{P} k(P') dP'\right\}}{\dot{P}^{-1} \int_{0}^{Pc} k(P) \exp\left\{-\dot{P}^{-1} \int_{0}^{P} k(P') dP'\right\} dP} \qquad (3)$$
$$Q(P) = \int_{0}^{P} p(P') dP' \qquad (4)$$

ここでk(P)は荷重Pでの転位核生成頻度であり、次式で表される.

$$k(P) = \sum_{i}^{N} k_0(\boldsymbol{R}_i) \exp\left\{\frac{-G(P, \boldsymbol{R}_i)}{k_{\rm B}T}\right\}$$
(5)

$$G(P, \mathbf{R}_i) = E(P, \mathbf{R}_i) \left(1 - \frac{T}{T_{\rm m}}\right)$$
(6)

ここで $R_i$ は核生成が起こりうるサイト(核生成サイト) iの位置,Nはモデル中の核生成サイトの数, $k_0$ は核生成サ イトiでの頻度因子, $G(P, R_i)$ は荷重P,位置 $R_i$ における転 位核生成の活性化自由エネルギー, $k_B$ はボルツマン定数,  $T_m$ は材料の融点である. $k_0$ は1.0×10<sup>13</sup> s<sup>-1</sup>, $T_m$ は 923 K<sup>7)</sup> とした.また本研究では、最大のせん断応力の発生箇所から転位核生成が生じると仮定しているため、これに基づいて転位核生成頻度k(P)を次式のように近似した.

$$k(P) \approx N_{\rm eq} k_0 \left( \boldsymbol{R}_{\rm MRSS}(P) \right) \exp \left\{ \frac{-G\left( P, \boldsymbol{R}_{\rm MRSS}(P) \right)}{k_{\rm B} T} \right\}$$
(7)

 $N_{eq}$ はナノインデンテーション解析におけるモデルと圧子 の配置における等価なすべり系の数 (本解析では $N_{eq} = 3$ ),  $R_{MRSS}(P)$ は荷重Pにおいて最大のせん断応力が生じる位 置を示す.以上の式(3)~(7)を用いて,異なる押し込み速 度 $\dot{P}$ ,温度Tでの pop-in 荷重の確率分布を求めることで, pop-in 発生荷重の温度・押し込み速度依存性の予測を実 施した.

## 3. 解析結果

前節に記載した各解析項目の結果を以下に記す.

3.1 ナノインデンテーション MD 解析 (Step 1 結果) 横軸を圧子の押し込み変位,縦軸を押し込み荷重とし てプロットした荷重-変位線図を図3に示す.なお,本解 析は荷重制御ではなく変位制御であるため,pop-in 現象 は線図上では変位バーストの代わりに,急激な荷重低下と して観測される.図3(a)の底面押し込み,(b)の柱面押し 込みにおいてそれぞれ圧子を1.23 nm, 0.38 nm 押し込ん だ段階で荷重低下が見られ,pop-in の発生が確認された. 底面押し込みに比べ,柱面押し込みの方が pop-in 発生荷



重が低く,また発生規模(荷重低下量)も小さくなってい る.底面押し込み,柱面押し込みそれぞれのpop-in 発生 前後の圧子直下の描像を図4に示す.この図は原子を配位 数によって色分けし,その結果に基づいて表面と欠陥部分 のみを表示したものである.底面押し込み,柱面押し込み それぞれ1.23 nm,0.40 nmの時点で転位ループの生成が 見られ,図3の荷重-変位線図と対応していることを確認 した.また両押し込み条件ともに転位ループは底面上に生 成されていることが確認でき,したがってこれらの転位は 底面すべりによるものであると考えられる.この pop-in の発生時点より前の数段階において,圧子直下の原子の中 ですべり系に対する最大の分解せん断応力成分を有する 原子応力テンソルを記録した.



#### 3.2 転位核生成の活性化エネルギー (Step 2 結果)

Step 1 のナノインデンテーション MD 解析より得られた 原子応力テンソルを基に, NEB 法に基づくナノインデンテ ーション中の転位核生成の最小エネルギー経路解析を実 施した. 横軸を押し込み荷重P, 縦軸をEとして, 転位核生 成の活性化エネルギーの荷重依存性を底面押し込み, 柱面 押し込みともにプロットしたものを図5に示す. 曲線は式 (2)によるフィッティングカーブである. いずれの押し込 み条件でも, 荷重Pが高くなるにつれ, 活性化エネルギー Eが減少する傾向を確認した. 柱面押し込みにおけるナノ インデンテーション解析における pop-in 荷重Pcの値は底



面押し込みでのPcの 1/10 であるため,柱面押し込みの荷 重-活性化エネルギー曲線の勾配が非常に大きくなってい ることがわかる.

# 3.3 Pop-in 発生荷重の温度・押し込み速度依存性の予 測結果 (Step 3 結果)

Pop-in 発生荷重の温度依存性の予測結果として,押し 込み速度 50 µN/s での温度 300,500,700 Kの累積確率 分布を図 6 に,押し込み速度依存性の予測結果として,温 度 300 K での押し込み速度 50,500,5000 µN/s の累積確 率分布を図 7 に示す.なお,横軸の押し込み荷重Pは臨界 荷重Pcで規格化したもので表示している.

温度依存性に関しては図6より、両押し込み条件ともに 温度の上昇に伴って pop-in 発生荷重は低くなり、温度300 K では臨界荷重 $P_c$ 付近にて急激に立ち上がる一方で、700 K では比較的緩やかに立ち上がる傾向が見られた.底面押し 込みと柱面押し込みとでは温度依存性に大きな差は見ら れないが、温度依存性の尺度として、各温度において popin 発生の累積確率Qの値が 0.5 となる荷重 $P_{0.5}(T)$ を考え、 例えば 700 K と 300 K におけるその値の差を $P_c$ で除した値





を見積もったところ,底面押し込みは0.060,柱面押し込 みは0.025となり,柱面押し込みの方が温度依存性が小さ いと考えられる.これは柱面押し込みの方が荷重-活性化 エネルギー曲線(図5参照)の勾配が急であることから, 熱的運動によって活性化エネルギーを越えることができ る範囲が狭いためだと考えられる.

押し込み速度依存性に関しては図7より,温度300Kの 場合では両押し込み条件ともに押し込み速度依存性はき わめて小さい傾向が見られた.そこで温度を700Kとして 押し込み速度50,500,5000 µN/sの累積確率分布を算出 したものを図8に示す.温度300Kの場合と比較すると, 700Kの場合では押し込み速度依存性が大きくなり,押し 込み速度が遅くなるほど発生荷重が低くなる傾向が見ら れ,柱面押し込みの場合では底面押し込みの場合よりもわ ずかに押し込み速度依存性が大きくなった.

以上の結果より,底面押し込み,柱面押し込みともに pop-in 発生荷重は温度が高くなるほど,また押し込み速 度が遅くなるほど低くなる傾向が見られた.本研究では pop-in において活動するすべり系として底面すべりのみ を対象としたが,今後は柱面すべり,錐面すべりにおける 活性化エネルギーを算出し,各すべり系の pop-in への寄 与の度合いを比較することで、より詳細な議論が可能とな ると考える.



### 4. まとめ

本研究では六方稠密(HCP)構造を有するマグネシウム (Mg)の塑性変形機構の理解の深化のため,底面と柱面へ のナノインデンテーション MD 解析を実施して圧子直下に 生じる原子応力状態を取得し、それに基づいて転位の核生 成に起因する第一 pop-in の発生荷重の温度・押し込み速 度依存性の予測を実施した.予測した pop-in 荷重の温度・ 押し込み速度依存性は底面押し込み、柱面押し込みともに 温度が高くなるほど、また押し込み速度が遅くなるほど低 くなった.押し込み速度依存性は室温下(300 K)では極 めて小さかったが、700 K では比較的大きく見られるよう になった.柱面押し込みは底面押し込みよりも pop-in 発 生荷重が小さくなり、荷重-活性化エネルギー関係の勾配 が大きく、温度依存性が小さいことが明らかとなった.

#### 謝 辞

本研究の遂行に当たり,公益財団法人 天田財団により 2021 年度奨励研究助成(若手研究者枠)AF-2021038-C2の 支援を受けました.ここに付記し,財団および関係各位に 心より深く感謝の意を表します.

#### 参考文献

- 日本塑性加工学会:マグネシウム加工技術,(2004), 16.
- 2) 沼倉宏:まてりあ, Vol. 37, (1998), 117-124.
- Y. Sato, S. Shinzato, T. Ohmura, T. Hatano, S. Ogata: Nat. Commun., Vol. 11, (2020), 4177.
- A. P. Thompson, H. M. Aktulga, R. Berger, D. S. Bolintineanu, W. M. Brown, P. S. Crozier, P. J. in 't Veld, A. Kohlmeyer, S. G. Moore, T. D. Nguyen, R. Shan, M. J. Stevens, J. Tranchida, C. Trott, S. J. Plimpton: Comp. Phys. Comm., Vol. 271, (2022), 108171.
- Z. Wu, M. F. Francis, W. A. Curtin: Model. Simul. Mater. Sci. Eng., Vol. 23, (2015), 015004.
- G. Henkelman, H. Jónsson: J. Chem. Phys., Vol. 113, (2000), 9978-9985.
- 7) 小島陽:表面技術, Vol. 44, (1993), 866-873.